









	<h2 style="color: red;">SI3879DV-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI3879DV-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP
	Datenblätter:  SI3879DV-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3879DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 3.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	480pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.5nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 5A (Tc) 2W (Ta), 3.3W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)

SI3879DV-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI3879DV-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI3879DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI3879DV-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI3867DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.9A 6-TSOP</p>	 <p>SI3867DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.9A 6-TSOP</p>	 <p>SI3900DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 2A 6-TSOP</p>	 <p>SI3900DV-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 2A 6-TSOP</p>
 <p>SI3879DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3879DV-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3879DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3900DV VISHAY SI3900DV VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI3879DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI3879DV-T1-GE3 Datenblatt	SI3879DV-T1-GE3-Datenblätter	SI3879DV-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI3879DV-T1-GE3
SI3879DV-T1-GE3 Electronic	SI3879DV-T1-GE3-Komponenten	SI3879DV-T1-GE3-Verteiler	SI3879DV-T1-GE3-Bild	SI3879DV-T1-GE3-Teil
SI3879DV-T1-GE3 Preis	SI3879DV-T1-GE3 Hersteller	SI3879DV-T1-GE3 Bild	SI3879DV-T1-GE3 Aktie	SI3879DV-T1-GE3 Inventar
SI3879DV-T1-GE3 Neu	SI3879DV-T1-GE3 Original	SI3879DV-T1-GE3 garantiert	SI3879DV-T1-GE3 RFQ	SI3879DV-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited